

日程表（会場別） 1

神奈川工科大学

会場名		収容人数	3月24日（木）		3月25日（金）		3月26日（土）		3月27日（日）	
			午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
K1号館	KA B1F-B101	108	5.2 光記録／ストレージ 5.3 光制御	5.3 光制御	「ナノエレクトロニクス研究の国際連携」	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象
	KB B1F-B102	108	5.3 光制御	5.3 光制御	5.4 光ファイバー	「最新の大容量光ファイバ伝送技術と関連基盤技術-100テラビット伝送は可能か?」	5.3 光制御	5.3 光制御	5.3 光制御	5.3 光制御
	KC 2F-201	114	「半導体プロセス・デバイス・回路のモデリングとシミュレーション」	「半導体プロセス・デバイス・回路のモデリングとシミュレーション」	13.6 Siデバイス／集積化技術	「超低電力デバイス技術と回路・アプリケーション連携」	13.6 Siデバイス／集積化技術	13.6 Siデバイス／集積化技術	13.6 Siデバイス／集積化技術	13.6 Siデバイス／集積化技術
	KD 2F-202	183	スクール「励起ナノプロセス入門ー基礎と将来展望ー」		界面ナノ電子化学研究会企画「固液界面現象の最前線 - 青木秀充先生追悼シンポジウム」	「非鉛系圧電材料の開発・応用の現状」	13.6 Siデバイス／集積化技術	13.6 Siデバイス／集積化技術		
	KE 3F-303	84	7.4 ナノインプリント	7.4 ナノインプリント	9.4 熱電変換	9.4 熱電変換	4.1 量子光学・原子光学	17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.3 新機能探索・基礎物性評価
	KF 3F-305	84	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.6 レーザー分光応用・計測	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	15.1 バルク結晶成長	15.1 バルク結晶成長	15.5 IV 族結晶、IV-IV 族混晶	15.5 IV 族結晶、IV-IV 族混晶
	KG 3F-306	84		4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料
	KH 6F-602	80	12.4 光機能材料・デバイス	12.4 光機能材料・デバイス	4.7 レーザー・プロセスング	4.7 レーザー・プロセスング	4.7 レーザー・プロセスング	4.7 レーザー・プロセスング		
	KJ 6F-604	74		8.1 プラズマ生成・制御	11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長（ショート口頭講演）	11.4 アナログ応用および関連技術	11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	12.6 高分子・ソフトマテリアル	
	KL 12F-メディアホール	276	スクール「100年の歴史に学ぶ超伝導」		3.5 情報光学	「キャリアデザインと学会活動 出会える人・テーマ・チャンス」	合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」（ショート口頭講演）	「不純物機能活性型半導体の物性制御とデバイス応用：21世紀型シリコンテクノロジー：低炭素化の促進に向けて」		
K2号館	KM 3F-1301	73	13.1 基礎物性・評価	13.1 基礎物性・評価	10.1 新物質創成（酸化物・ホイスラー・金属磁性体等）（ショート口頭講演）	重力的応用研究グループ企画「重力場応用研究」（ショート口頭講演）	10.1 新物質創成（酸化物・ホイスラー・金属磁性体等）（ショート口頭講演）	10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス	10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス	
	KN 3F-1302	69		18.7 磁場応用	18.1 応用物理一般	18.1 応用物理一般	18.5 エネルギー変換・貯蔵 18.6 資源・環境	18.4 トライボロジー 18.3 新技術		
	KQ 3F-1307	124	10.2 スピントロクスピン流・回路・測定技術	「スピントロニクス不揮発メモリ・不揮発ロジックの現状と展望」	10.2 スピントロクスピン流・回路・測定技術	10.2 スピントロクスピン流・回路・測定技術	17.4 デバイス応用	17.4 デバイス応用	17.4 デバイス応用	17.4 デバイス応用
	KR 3F-1308	69	9.2 微粒子・粉体 9.3 ナノエレクトロニクス	9.3 ナノエレクトロニクス	2.2 精密計測・ナノ計測	2.3 計測標準	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術		
	KS 4F-1401	73	14.3 プロセス技術・界面制御	14.3 プロセス技術・界面制御	3.1 物理光学・光学基礎	3.2 材料光学	13.4 配線技術	13.7 シミュレーション		
	KT 4F-1402	69	9.1 誘電材料・誘電体	3.4 計測光学	3.4 計測光学	3.4 計測光学	9.3 ナノエレクトロニクス	3.8 光学新領域		
	KU 4F-1403	73	2.1 計測・制御技術（ショート口頭講演）	「ついに始まった重力波観測用巨大干渉計の建設」	3.3 機器・デバイス光学（ショート口頭講演）	「衝撃応用研究グループ企画「衝撃の科学とその利用」」	14.1 探索的材料物性	14.1 探索的材料物性	14.1 探索的材料物性	
	KV 4F-1406	85	17.2 構造制御・プロセス	17.2 構造制御・プロセス	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14.2 超薄膜・量子ナノ構造		
	KW 4F-1407	108	14.6 化合物太陽電池	シリコンテクノロジー分科会受賞記念講演	13.3 絶縁膜技術	13.3 絶縁膜技術	13.3 絶縁膜技術	13.3 絶縁膜技術	13.3 絶縁膜技術	
	KX 4F-1409	73	7.1 X線技術（ショート口頭講演）	「二次イオン質量分析法の新展開 - はやぶさからバイオテクノロジーまで -」	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般	7.5 ビーム・光励起表面反応 7.8 ビーム応用一般・新技術	7.7 微小電子源		
C1号館	CA 4F-閲覧室	130	講演奨励賞贈呈式	評議員会 業績賞・研究分野業績賞授賞式	「X線・放射光による埋もれた界面の構造計測」	「X線・放射光による埋もれた界面の構造計測」	11.1 基礎物性	11.1 基礎物性		
C5号館	CB 2F-5224	150	9.4 熱電変換	「見直され始めたシリサイド系熱電材料〜実用化への課題と解決策を探る〜」	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ
	CD 3F-5310	90	12.1 作製技術	12.1 作製技術	12.1 作製技術	12.1 作製技術	12.1 作製技術	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性
	CE 3F-5324	110	15.7 エピタキシーの基礎	「ソーラーシリコンの生産技術革新とサハラスーパーエネルギー戦略」	13.4 配線技術	「13.4 配線技術」分科内総合講演「高集積微細デバイスにおける今後の信号伝達 / 配線技術」	11.4 アナログ応用および関連技術	「超伝導検出器で実現する次世代先端分析技術」	11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用
C6号館	CF 1F-106	89		「KPS-JSAP Joint Symposium "Solar Cell Activities in Japan and Korea" organized by Solid State Physics and Applications Division」	12.5 液晶	12.5 液晶	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.5 プラズマナノテクノロジー	
E3号館	EA 1F-102	126	1.2 放射線発生装置・理工学応用	1.3 放射線応用・新技術	1.3 放射線応用・新技術	放射線分科会企画「二次元放射線検出器の最前線」	1.1 放射線物理一般・検出器基礎	1.1 放射線物理一般・検出器基礎	1.1 放射線物理一般・検出器基礎	1.1 放射線物理一般・検出器基礎
	EB 3F-303	126	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	応用物理教育分科会企画「物理のおもしろさを生徒や学生にいかにつづけるか? 中学、高校、大学における"環境・エネルギー"の授業を中心にして」	8.4 プラズマエッチング	8.4 プラズマエッチング		

日程表（会場別） 2

神奈川工科大学

会場名		収容人数	3月24日(木)		3月25日(金)		3月26日(土)		3月27日(日)	
			午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
B5号館	BA 1F-2101	80	7.2 電子顕微鏡、評価、測定、分析	13.2 半導体表面	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	16.2 プロセス技術・デバイス	16.2 プロセス技術・デバイス
	BC 1F-2102	80	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜
	BD 1F-2103	192	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	12.11 特定テーマ「有機太陽電池」	12.8 有機EL	12.8 有機EL	12.8 有機EL
	BE 1F-2104	192	6.1 強誘電体薄膜(ショート口頭講演)	薄膜・表面物理分科会企画「産業利用に向けた放射光を使った最先端測定技術」	8.1 プラズマ生成・制御	光学論文受賞記念講演	6.1 強誘電体薄膜(ショート口頭講演)	「ナノ光子系と情報の融合が拓くシステムの質的変革」		
	BF 1F-2105	184	6.3 酸化物エレクトロニクス	機能性酸化物研究グループ企画「酸化物ヘテロ構造を用いた強相関電子制御の最前線」	5.3 光制御	「非線形光学50周年に分極反転はどこまで来たか？」	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス
	BG 1F-2106	184	3.7 近接場光学	「アクティブ・プラズモニクス」	12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」	「確率的過程に基づく電子材料・デバイス・システムの展開」	8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.3 プラズマ成膜・表面処理
	BH 2F-2201	80	3.5 情報光学	新画像システム研究会企画「画像入力質を高めるデバイス・処理技術」	3.7 近接場光学	3.7 近接場光学	3.7 近接場光学	3.6 生体・医用光学	3.6 生体・医用光学	3.6 生体・医用光学
	BJ 2F-2202	80	7.3 リングラフィ	7.3 リングラフィ	16.1 基礎物性・評価	16.1 基礎物性・評価	3.4 計測光学	「光波センシングのための偏光技術の進展」	3.5 情報光学	3.5 情報光学
	BK 2F-2203	196	16.3 シリコン系太陽電池	「薄膜トランジスタ、薄膜太陽電池のプロダクション科学 - 半導体薄膜の低温結晶化 -」	16.3 シリコン系太陽電池	日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会合同企画「極限シリコン結晶太陽電池の実現に向けて」	12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」	12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」		
	BL 2F-2204	192	特別シンポジウム「有機分子・バイオエレクトロニクス分科会の新たな挑戦」		15.6 IV 族系化合物	15.6 IV 族系化合物	16.3 シリコン系太陽電池	ランダム系フォトリソグラフィ研究会企画「環境・エネルギー希土類フォトリソグラフィを支える最先端ガラス中国研究事情と最近のトピックス」	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池
	BM 2F-2205	357	「ナノカーボン材料の最新動向(2): グラフェンおよびナノチューブ」	「ナノカーボン材料の最新動向(2): グラフェンおよびナノチューブ」	17.1 成長技術	「グラフェンエピタキシーの現状と将来展望」	17.1 成長技術	17.1 成長技術	17.1 成長技術	17.1 成長技術
	BN 2F-2206	357	15.6 IV 族系化合物	「グリーンイノベーションに向けたSiCパワーエレクトロニクス開発の進展」	「CIGS系太陽電池の作製プロセスの進展と残された課題」	「CIGS系太陽電池の作製プロセスの進展と残された課題」	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	「トップダウンとボトムアップの融合による量子ナノ構造作製プロセスのブレークスルーと新たなデバイスへの展開」		
	BQ 3F-2301	98	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	「ラマン分光イメージングが拓く新しいサイエンスとテクノロジー」	「ラマン分光イメージングが拓く新しいサイエンスとテクノロジー」	15.2 II-VI 族結晶	15.2 II-VI 族結晶
	BR 3F-2302	98		「グリーンイノベーションを実現するレーザープロセス技術」	17.2 構造制御・プロセス	「生物の電磁場応答研究の最前線〜ヒトの視覚から細胞(分子)レベルまで〜」	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡
	BS 3F-2303	196	合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」(ショート口頭講演)	「電磁メタマテリアルの現状と将来」	合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」(ショート口頭講演)	「プラズマエレクトロニクス分科会企画 プラズマテクノロジーが未来を創る プラズママップから見るプラズマプロセス技術の将来展望」		応用電子物性分科会総会 APEX/JJAP フレンドシップミーティング		
	BT 3F-2304	196	「量子情報：高まる技術と深まる科学」	「量子情報：高まる技術と深まる科学」		エネルギー・環境研究会企画「新エネルギーとそのネットワーク化スマートグリッドにおける応用物理の果たすべき役割と新しい可能性」	14.6 化合物太陽電池	14.6 化合物太陽電池	14.6 化合物太陽電池	14.6 化合物太陽電池
	BU 3F-2305	354	12.9 有機トランジスタ(ショート口頭講演)	14.6 化合物太陽電池	12.9 有機トランジスタ(ショート口頭講演)	12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ
	BV 3F-2306	354	12.10 ナノバイオテクノロジー(ショート口頭講演)	「人工光合成は日本のエネルギー問題を解決できるか？」	12.10 ナノバイオテクノロジー(ショート口頭講演)	「異種機能集積化: MEMS と LSI の融合の実態と今後の展開」	特別シンポジウム「異種機能集積化と応用物理〜最先端多様分野の融合によって拓かれる未来社会〜」			
	BW 4F-2403	164	14.5 光物性・発光デバイス	14.5 光物性・発光デバイス	14.5 光物性・発光デバイス	14.5 光物性・発光デバイス	14.5 光物性・発光デバイス	14.5 光物性・発光デバイス	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学
	BX 4F-2404	168	「光科学の未来を拓く - 10年先の新規研究領域開拓のために -」	「光科学の未来を拓く - 10年先の新規研究領域開拓のために -」	「光科学の未来を拓く - 10年先の新規研究領域開拓のために -」	「光科学の未来を拓く - 10年先の新規研究領域開拓のために -」	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	応用物理学会 THz 電磁波技術研究会企画「テラヘルツデバイス: 新展開」	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学
	BY 4F-2405	357	15.4 III-V 族化合物結晶	15.4 III-V 族化合物結晶	15.4 III-V 族化合物結晶	15.4 III-V 族化合物結晶	15.4 III-V 族化合物結晶	15.4 III-V 族化合物結晶	15.4 III-V 族化合物結晶	15.4 III-V 族化合物結晶
	BZ 4F-2406	357	12.3 電子機能材料・デバイス	12.3 電子機能材料・デバイス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	15.4 III-V 族化合物結晶	15.4 III-V 族化合物結晶	15.4 III-V 族化合物結晶	15.4 III-V 族化合物結晶
第一体育館	ポスターセッション		13.5 Si プロセス技術<第一>		13.5 Si プロセス技術<第一>		5.1 半導体レーザー・発光/受光素子<第一>		14.4 超高速・機能デバイス<第一>	
			[前半] 6.1 強誘電体薄膜<第一> [後半] 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」<第一>		[前半] 12.10 ナノバイオテクノロジー<第一> [後半] 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」<第一>		[前半] 6.1 強誘電体薄膜<第一> [後半] 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」<第一>			
第二体育館	ポスターセッション		9.5 新機能材料・新物性<第二> 8.2 プラズマ診断・計測<第二>		18.2 教育<第二>		15.8 結晶評価、ナノ不純物・結晶欠陥<第二>		5.1 半導体レーザー・発光/受光素子<第二>	
			[前半] 2.1 計測・制御技術<第二> 12.10 ナノバイオテクノロジー<第二> [後半] 7.1 X線技術<第二> 12.9 有機トランジスタ<第二>		[前半] 10.1 新物質創生(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)<第二> 11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長<第二> [後半] 3.3 機器・デバイス光学<第二> 12.9 有機トランジスタ<第二>		[前半] 10.1 新物質創生(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)<第二> [後半]			